

基本信息



姓名：高鼎三
 民族：汉族
 性别：男
 籍贯：宜兴市
 出生日期：1914年7月
 逝世日期：2002年6月13日

当选信息：
 1995年 中国工程院
 所属学部：
 中国工程院 信息与电子工程学部

院士简介

高鼎三（1914.07.24-2002.06.13）半导体与光电子学专家。上海市人。1941年毕业于西南联合大学，1953年获美国加利福尼亚大学硕士学位。我国半导体事业开拓者之一。在国内首先研制成大功率整流器、点接触二极管、三极管、光电二极管，较早研制成功GaAs激光器，500A、2500V大功率晶闸管。获全国科学大会奖，国家发明奖三等奖两项、四等奖1项，电子工业部科技奖进步一等奖1项，国家教委科技进步奖二等奖1项。在1986年国务院召开的“863”计划专家座谈会上，积极建议把光电子技术列为高技术的独立项目。并承担了“863”计划中“可见光激光器”的结构设计及工艺研究和“半导体激光器热传输特性”等研究项目，取得很大成绩。出版专译著2部，发表独立或合作论文100余篇。培养硕士、博士生、博士后50余名。

1995年当选为工程院院士。

主要学历

1934年 - 1937年 上海大同大学附中（高中）
 1938年 - 1941年 国立西南联合大学 物理系 学士
 1947年 - 1951年 美国加利福尼亚大学 物理系 硕士
 1951年 - 1953年 美国加利福尼亚大学 物理系 博士

主要经历

1948年 - 1951年 美国加利福尼亚大学 助教
 1951年 - 1953年 美国洛杉矶国际整流器公司 研究员
 1955年 - 1959年 东北人民大学物理系 副主任、副教授
 1959年 - 1984年 吉林大学半导体系 系主任
 1984年 - 2002年 吉林大学电子工程系 名誉系主任

1990年 - 1993年 集成光电子学国家重点实验室学术委员会 主任

本资料由中国工程院院士馆提供

